#### 02

# Влияние температуры и магнитного поля на процессы эволюции вихревой структуры гранулярного высокотемпературного сверхпроводника YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7-δ</sub>

© В.В. Деревянко, Т.В. Сухарева, В.А. Финкель, Ю.Н. Шахов

Харьковский физико-технический институт НАН Украины, Харьков, Украина

E-mail: finkel@kipt.kharkov.ua

(Поступила в Редакцию 15 июля 2013 г.)

Во внешних магнитных полях  $\mathbf{H}_{\text{ext}}$  ( $0 \le H_{\text{ext}} \le 1420 \,\text{Oe}$ ) в диапазоне температур 70–273 К для образцов гранулярного высокотемпературного сверхпроводника (ВТСП) YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7-\delta</sub> проведены измерения температурных зависимостей электросопротивления  $\rho(T)_{H=\text{const}}$ . Охлаждение образцов до  $T_{\min}(70 \,\text{K})$  проводилось как во внешних полях (FC-режим), так и в отсутствие магнитного поля (ZFC-режим). Кроме того, в нулевом поле получены зависимости  $\rho(T)_{H=0}$  для образцов, охлажденных в FC-режиме. Кривые  $\rho(T)_{H=\text{const}}$  преобразовывались в изотермы магнитосопротивления  $\rho(H_{\text{ext}})_{T=\text{const}}$ . Сравнительный анализ особенностей поведения кривых  $\rho(H)_{T=\text{const}}$  образцов с различной "магнитной предысторией" дает возможность установить природу и механизмы влияния особенностей сценария магнитной обработки гранулярных ВТСП на характер поведения их гальваномагнитных свойств. Определены температурные зависимости величин критических магнитных полей сверхпроводящих гранул ( $H_{c1g}, H_{c2g}$ ) и джозефсоновских слабых связей ( $H_{c2J}$ ); восстановлены фазовые H-T-диаграммы гранулярных ВТСП YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7-δ</sub>.

#### 1. Введение

Хорошо известно, что гранулярные высокотемпературные сверхпроводники (ВТСП), типичным представителем которых может служить металлооксидное соединение YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7-δ</sub> с критической температурой  $T_c \sim 92.5 \,\mathrm{K}$ , по существу являются двухфазными системами — совокупностью двух различных сверхпроводников второго рода [1]: трехмерных сверхпроводящих гранул с сильной сверхпроводимостью и двумерных межгранульных границ — джозефсоновских слабых связей (weak links) со слабой сверхпроводимостью. Описание поведения электромагнитных свойств гранулярных ВТСП в магнитном поле возможно в рамках двухуровневой модели критического состояния [2] или родственных ей моделей (см., например, [3]). В рамках двухуровневой модели постулируется, что параметры сверхпроводимости: критические температуры T<sub>c</sub>, нижние H<sub>c1</sub> и верхние H<sub>c2</sub> критические поля и критические токи I сверхпроводящих гранул (g) и слабых связей (J) соотносятся как

$$H_{c1g} \gg H_{c1J}, \quad H_{c2g} \gg H_{c2J},$$
  
 $I_g \gg I_J.$  (1)

Хотя система уравнений (1) в целом адекватно описывает поведение критических полей и токов обоих уровней (подсистем) системы гранулярных ВТСП в широком диапазоне температур и магнитных полей, подобное описание носит чисто качественный характер. Действительно, при изучении транспортных и магнитных свойств

 $T_{cg} = T_{cJ},$ 

гранулярных ВТСП обнаружен ряд существенных особенностей, а именно: 1) зависимость величин критических полей  $H_{c2J}$  и  $H_{c1g}$  от плотности транспортного тока J (см., например, [4–7]), 2) влияние особенностей сценария приложения внешнего магнитного поля  $\mathbf{H}_{ext}$  к гранулярному образцу ВТСП: охлаждение в поле  $\mathbf{H}_{ext}$  — FC — или охлаждение в нулевом поле и "включение" поля  $\mathbf{H}_{ext}$  при заданной температуре  $T < T_c$  — ZFC (см., например, [7–10]).

Все это свидетельствует, в частности, в пользу дальнейшего применения и развития экспериментальных методов изучения различных аспектов проблемы взаимодействия магнитного поля с обеими подсистемами двухуровневой системы гранулярных ВТСП (со сверхпроводящими гранулами и слабыми связями). Основную информацию о взаимодействии магнитного поля со сверхпроводящими гранулами и слабыми связями, как правило, получают на основании изучения гальваномагнитных эффектов — магнитосопротивления  $\rho(H)$ , т.е. свойства материала изменять электрическое сопротивление под действием внешнего магнитного поля Hext (или предварительно приложенного "поля обработки" **H**<sub>treat</sub>), и получения вольт-амперных характеристик (ВАХ) в магнитном поле  $V(J)_{H=\text{const}}$  (или  $E(J)_{H=\text{const}}$ , где E напряженность электрического поля E<sub>ext</sub>). Результаты измерений ВАХ также представляют в виде  $\rho(J)_{H=\text{const.}}$ 

Несмотря на то что изучению магнитосопротивления и в меньшей степени ВАХ в магнитном поле в гранулярных ВТСП  $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$  посвящено огромное количество работ (см., например, [10–20]), следует иметь в виду то немаловажное обстоятельство, что подавляющее большинство исследований проведено с использованием в качестве хладагентов криогенных жидкостей (как правило, жидкого азота с температурой кипения  $T_{\text{boil}} = 77.36 \text{ K}$ ). В связи с тем, что список криогенных жидкостей крайне ограничен, не получило должного развития такое направление исследований гальваномагнитных эффектов в гранулярных ВТСП, как изучение температурных зависимостей электросопротивления в магнитном поле  $\rho(T)_{H=\text{const.}}$  Имеется в виду как внешнее магнитное поле  $\mathbf{H}_{\text{ext.}}$  так и "поле обработки"  $\mathbf{H}_{\text{treat.}}$ 

Целью настоящей работы является установление природы и механизмов эволюции вихревой структуры гранулярного высокотемпературного сверхпроводника YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7-δ</sub> под действием температуры и магнитного поля. Для достижения цели работы необходимо было провести следующие разработки и исследования:

1) разработать и практически реализовать экспериментальную установку для измерения электросопротивления при температурах ~  $15 \le T \le 273$  K во внешних магнитных полях  $0 \le H_{\text{ext}} \le 1420$  Oe на основе криогенератора RGD-210 (Leybold);

2) провести измерения электросопротивления в магнитном поле  $\rho(T)_{H=\text{const}}$  в диапазоне температур  $70 \le T \le 95 \text{ K}$  в магнитных полях  $0 \le H_{\text{ext}} \le 1420 \text{ Oe}$ при различных способах приложения магнитного поля;

3) восстановить на основании полученных зависимостей  $\rho(T)_{H=\text{const}}$  изотермы магнитосопротивления  $\rho(H)_{T=\text{const}}$  при различных способах приложения магнитного поля;

4) провести сравнительный анализ зависимостей  $\rho(T)_{H=\text{const}}$ ,  $\rho(H)_{T=\text{const}}$  и значений критических полей фазовых переходов в вихревой структуре при различных способах приложения магнитного поля.

# 2. Методические аспекты исследований

Развитый в рамках настоящей работы методический подход к изучению процессов эволюции вихревой структуры гранулярных ВТСП, основанный на проведении низкотемпературных резистивных измерений в магнитном поле, включает следующие направления методических исследований и разработок:

1) получение и аттестация гранулярных образцов ВТСП  $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ ;

2) разработка и создание аппаратуры для проведения резистивных измерений в магнитном поле при низких температурах;

 разработка и оптимизация программы проведения магнитной обработки объектов исследования;

4) создание алгоритма преобразования полученных экспериментальных данных к виду, адекватному задаче исследований.

2.1. Образцы для исследований. Объектами исследования служили образцы гранулярного ВТСП  $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$  номинального состава  $YBa_2Cu_3O_{6.95}$ , синтезированные по стандартной "керамической технологии" [21]. Размер образцов составлял  $\sim 2 \times 2 \times 20$  mm.

Токовые и потенциальные контакты наносились путем осаждения паров серебра в вакууме. Заключительный отжиг образцов в окислительной среде при 940°С с последующим медленным охлаждением проводился после нанесения Ag-контактов, что приводило к существенному снижению контактного сопротивления на границе  $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}/Ag$ .

Для аттестации образцов ВТСП состава YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>6.95</sub> использовали методы рентгеноструктурного анализа, резистивных и магнитных измерений критической температуры  $T_c$ . Образцы были практически однофазными, значения параметров кристаллической решетки в пределах точности измерений совпадали с табличными значениями. Температура середины сверхпроводящего перехода  $T_c^{1/2}$  составляла 92.65 ± 0.05 K, ширина перехода  $\Delta T_c \approx 0.2$  K, удельное электросопротивление  $\rho_{273 \text{ K}} \approx 1000-1200 \,\mu\Omega \cdot \text{сm}.$ 

2.2. Установка для измерения температурных зависимостей электросопротивления в магнитном поле. Схема установки для измерения электросопротивления в диапазоне температур  $\sim 15 \leq T \leq 273$  К во внешних магнитных полях  $0 \leq H_{\rm ext} \lesssim 1500$  Ос представлена на рис. 1.

Установка фактически состоит из двух крупных блоков: стационарного устройства для создания низких температур 5 (криогенератор RGD-210 (Leybold)) и съемного устройства 3 для создания достаточно сильных



**Рис. 1.** Схема установки для измерения электросопротивления в магнитном поле при низких температурах. *1* — образец, *2* — измерительная ячейка, *3* — держатель постоянных магнитов, *4* — магниты, *5* — криогенератор RGD-210 (Leybold).

магнитных полей на основе системы из пар постоянных магнитов 4 из высококоэрцитивного сплава Nd<sub>2</sub>Fe<sub>14</sub>B. Исследуемый образец 1 вместе со стандартным Ptтермометром сопротивления располагался внутри измерительной ячейки 2, заполненной перед началом работы газообразным гелием для повышения теплообмена.

Напряженность действующего на образец внешнего магнитного поля Hext определяется параметрами используемого набора постоянных магнитов и расстоянием между симметрично расположенными относительно образца магнитами. Величину Нехt измеряли с помощью прибора Ш1-8 (измерителя магнитной индукции) с точностью ±1.5%. Весьма существенно то обстоятельство, что в конструкции установки внутренний диаметр цилиндрического съемного устройства — держателя магнитов 3 — лишь незначительно превышает диаметр цилиндрической поверхности рабочей части криогенератора 5. Конструкция держателя магнитов обеспечивает постоянство выполнения следующего условия: нормаль к поверхности плоского образца 1 (N) и создаваемое с помощью системы сменных постоянных магнитов 4 внешнее магнитное поле Hext расположены в одной плоскости. Наличие специального лимба позволяет устанавливать угол между векторами N и Hext с точностью  $\sim 1^\circ$  (в настоящей работе все измерения проводились в поперечных магнитных полях  $\mathbf{I} \perp \mathbf{H}_{ext}$ ).

2.3. Методика эксперимента. Во избежание появления гистерезисных и т.п. эффектов все измерения зависимости  $\rho(T)_{H=const}$  в рабочем диапазоне  $70 \le T \le 100$  К проводили при повышении температуры и при достаточно низких значениях измерительного тока (I = 10 mA); при столь низких значениях I влияние его на величины критических полей гранул и слабых связей исчезающе мало [4–7]. Приборы для измерений сопротивления и температуры через USB/GPIB interface (82357B) объединены с компьютером в единый автоматизированный измерительный комплекс на основе криогенератора RGD-210 (Leybold) [22].

В работе исследовались образцы гранулярного ВТСП состава  $YBa_2Cu_3O_{6.95}$ . Были использованы три вида магнитной обработки (далее используются условные обозначения 0H, HH и H0):

1) 0*H* — охлаждение в режиме ZFC (в нулевом магнитном поле) до 70 К, присоединение съемного блока с установленным значением  $H_{\rm ext}$ , измерение зависимости  $\rho(T)_{H={\rm const}}$ ;

2) *HH* — установление заданного значения  $H_{\text{ext}}$ , присоединение съемного блока к стационарному блоку, охлаждение в магнитном поле (режим FC) до 70 K, измерение зависимости  $\rho(T)_{H=\text{const}}$ ;

3) H0 (режим "магнитной закалки" или захваченного магнитного потока) — установление заданного значения  $H_{\rm ext}$ , присоединение съемного блока к стационарному блоку, охлаждение в режиме FC до 70 K, удаление съемного блока, измерение зависимости  $\rho(T)_{H={\rm const.}}$ 

Для всех способов приложения магнитного поля исходная температура на образце  $T_{\min}$  устанавливалась на

уровне 70 К (более глубокое охлаждение не требовалось, так как при  $T < T_{\rm min}$  для образцов всех типов величина  $\rho \equiv 0$ ). Заданная величина  $H_{\rm ext}$  устанавливалась на съемном блоке установки и контролировалась с помощью прибора Ш1-8.

2.4. Обработка результатов экспериментов. Прямым результатом измерений является получение температурных зависимостей электросопротивления образцов гранулярного ВТСП  $YBa_2Cu_3O_{7-\delta} - \rho(T)_{H=const}$ , в то время как для достижения цели исследования основной интерес представляют полевые зависимости магнитосопротивления  $\rho(H)_{T=const}$ . Это означает, что результаты измерений — кривые  $\rho(T)_{H=const}$ .

Хотя с математической точки зрения решение подобной задачи не представляет трудностей, для получения массива данных  $\rho(T, H)$  в формате, позволяющем производить такие преобразования, а также проводить сравнительный анализ серий измерений магнитосопротивления 0H, HH и H0, прежде всего, следует измерить зависимости  $\rho(T)_{H=\text{const}}$  при фиксированных значениях полей  $H_{\text{ext}}$  или  $H_{\text{treat}}$ . В настоящей работе выбраны следующие значения полей  $H_{\text{ext}}$  и  $H_{\text{treat}}$ : 0, 6.5, 10, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 300, 600 и 1420 Ое.

При выборе учитывалось то обстоятельство, что наиболее интересные особенности поведения гальваномагнитных свойств наблюдаются в диапазоне  $0 < H_{\text{ext}} \lesssim 100$  Ое. Кроме того, для реализации преобразований  $\rho(T)_{H=\text{const}}$  в  $\rho(H)_{T=\text{const}}$  нужно провести интерполяцию реально измеренных значений  $\rho(T)_{H=\text{const}}$  к определенным значениям температуры. При этом "шаг" интерполяции, как правило, составлял 0.5 К.

#### 3. Результаты исследования

3.1. Температурная зависимость электросопротивления в магнитном поле. На рис. 2–4 представлена часть кривых температурной зависимости электросопротивления  $\rho(T)_{H=\text{const}}$  для исследуемых образцов гранулярного высокотемпературного сверхпроводника YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7- $\delta$ </sub> во внешних магнитных полях  $0 \leq H_{\text{ext}} \leq 1420$  Ое или в полях обработки  $0 \le H_{\text{teat}} \le 1420$  Ое. Поля **H**<sub>ext</sub> были приложены в ZFCрежиме (0*H*) и FC-режиме (*HH*); для образцов серии *H*0 поле прикладывалось в FC-режиме при T = 70 K, а затем сбрасывалось.

На всех кривых  $\rho(T)_{H=\text{const}}$  наблюдаются две характерные особенности: появление достаточно узких "скачков" сопротивления при переходе в сверхпроводящее состояние (значению  $T_c$  соответствует положение максимума производной  $d\rho/dT$ ) и наличие на оси температур при  $T < T_c$  протяженных участков, на которых  $\rho \neq 0$  ("хвостов сопротивления"). Последний эффект свидетельствует о том, что электросопротивление в магнитном поле обращается в нуль при температурах  $T_{R=0} \leq T_c$ .

Из рисунков видно, что ход кривых  $\rho(T)_{H=\text{const}}$  и положение точек  $T_{R=0}$  явно зависят от способа приложения



**Рис. 2.** Кривые  $\rho(T)_{H=\text{const}}$  для гранулярного образца ВТСП YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7- $\delta$ </sub>, охлажденного в ZFC-режиме. Снизу вверх:  $H_{\text{ext}} = 0, 6.5, 10, 100, 600$  и 1420 Ос. На вставке — полевая зависимость критической температуры  $T_c$ .



**Рис. 3.** Кривые  $\rho(T)_{H=\text{const}}$  для гранулярного образца ВТСП YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7- $\delta$ </sub>, охлажденного в FC-режиме. Снизу вверх:  $H_{\text{ext}} = 0, 6.5, 10, 100, 600$  и 1420 Ое.



**Рис. 4.** Кривые  $\rho(T)_{H=\text{const}}$  для гранулярного образца ВТСП YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7- $\delta$ </sub>, охлажденного в FC-режиме, после выключения магнитного поля. Снизу вверх:  $H_{\text{treat}} = 0, 6.5, 10, 100, 600$ и 1420 Ос.

(0H, HH или H0) и величины магнитного поля  $\mathbf{H}_{\text{ext}}$ или  $\mathbf{H}_{\text{treat}}$ .

3.2. Магнитосопротивление в широком диапазоне температур. В результате преобразования кривых  $\rho(T)_{H=\text{const}}$  (рис. 2–4) по описанному выше алгоритму были рассчитаны изотермы магнитосопротивления  $\rho(H)_{T=\text{const}}$ . Для образцов серий 0*H* и *HH* изотермы  $\rho(H_{\text{ext}})_{T=\text{const}}$  представлены на рис. 5 и 6; для образцов гранулярного высокотемпературного сверхпроводника YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7- $\delta$ </sub> серии *H*0 изотермы  $\rho(H_{\text{treat}})_{T=\text{const}}$  приведены на рис. 7.

В первую очередь отметим, что в отличие от исходных кривых  $\rho(T)_{H=\text{const}}$ , различие между которыми носит чисто количественный характер, различие хода изотерм магнитосопротивления  $\rho(H)_{T=\text{const}}$  в зависимости от способа приложения магнитного поля зачастую носит качественный характер. При этом наблюдаются и общие черты поведения изотерм магнитосопротивления:

 наличие явно выраженной тенденции к сильному росту уровня магнитосопротивления при повышении температуры;

2) наличие тенденции к росту уровня магнитосопротивления при повышении напряженности магнитных полей  $\mathbf{H}_{ext}$  или  $\mathbf{H}_{treat}$ ;

3) появление особенностей (аномалий) в ходе изотерм магнитосопротивления  $\rho(H)_{T=\text{const.}}$ 

Качественные отличия заключаются в характере этих аномалий:

а) появление максимумов на кривых  $\rho(H_{\text{ext}})_{T=\text{const}}$  в случае приложения магнитного поля в ZFC-режиме (серия 0*H*, рис. 5);

b) появление перегибов кривых  $\rho(H_{ext})_{T=const}$  в случае приложения магнитного поля в FC-режиме (серия *HH*, рис. 6);



**Рис. 5.** Кривые  $\rho(H_{\text{ext}})_{T=\text{const}}$  для гранулярного образца ВТСП YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7- $\delta$ </sub>, охлажденного в ZFC-режиме. Снизу вверх: T = 82.0, 86.5, 87.8, 88.8, 89.4, 90.2 и 90.7 К.



**Рис. 6.** Кривые  $\rho(H_{\text{ext}})_{T=\text{const}}$  для гранулярного образца ВТСП YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7- $\delta$ </sub>, охлажденного в FC-режиме. Снизу вверх: T = 82.0, 86.5, 87.8, 89.4, 90.2 и 90.7 К.



**Рис. 7.** Кривые  $\rho(H_{\text{treat}})_{T=\text{const}}$  для гранулярного образца ВТСП YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7- $\delta$ </sub>, охлажденного в FC-режиме, после выключения магнитного поля. Снизу вверх: T = 90.0, 91.0, 91.2, 91.4, 91.6, 91.8 и 92.0 К.

с) выход кривых  $\rho(H_{\text{treat}})_{T=\text{const}}$  на насыщение в случае режима захваченного магнитного потока — приложение магнитного поля в FC-режиме, сброс поля (серия H0, рис. 7).

Кроме того, существенное различие в ходе изотерм магнитосопротивления  $\rho(H_{\text{ext}})_{T=\text{const}}$  и  $\rho(H_{\text{treat}})_{T=\text{const}}$  заключается в наличии начальных участков с нулевым сопротивлением в первых двух случаях и практически полном отсутствии подобных участков в третьем случае.

# 4. Обсуждение результатов

Приведенные выше результаты изучения температурных зависимостей электросопротивления в магнитном поле и магнитосопротивления в широком интервале температур образцов гранулярного высокотемпературного сверхпроводника  $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$  содержат данные, обработка и обсуждение которых необходимы для достижения цели работы — установления природы и механизмов эволюции вихревой структуры объекта исследования. Очевидно, что главным критерием появления качественных изменений в вихревой структуре гранулярных ВТСП является наличие фазовых переходов "по температуре" и "по магнитному полю".

Далее обсуждаются результаты исследования фазовых переходов по линиям границ  $H_{c2J}(T)$ ,  $H_{c1g}(T)$  и зависимость  $T_c(H)$ , физически эквивалентная линии  $H_{c2g}(T)$ на H-T-диаграмме. Отметим, что фазовые переходы, связанные с началом проникновения вихрей Джозефсона в межгранульные границы, протекающие по линии  $H_{c1J}(T)$ , не связаны с появлением явно выраженных особенностей поведения резистивных свойств гранулярных ВТСП [3,23].

4.1. Критическая температура фазового перехода из сверхпроводящего в нормальное состояние в магнитном поле В слабых внешних поперечных магнитных полях  $\mathbf{H}_{ext}$  на образце гранулярного высокотемпературного сверхпроводника  $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$  удалось обнаружить эффект понижения критической температуры фазового перехода из сверхпроводящего в нормальное состояние (*S*–*N*-перехода). Для иллюстрации на вставке к рис. 2 представлена полученная в прецизионных экспериментах, проведенных в окрестности  $T_c$  на образце серии *0H*, зависимость  $T_c(H_{ext})$  (напомним, что значения  $T_c$  определялись по положению максимума температурной зависимости производной  $d\rho/dT$ , см. подраздел 3.1.).

Прямая линия  $T_c(H_{ext})$  на рисунке по существу представляет собой линию S-N-фазовых переходов на H-Tдиаграмме. Величина наклона прямой  $T_c(H_{ext})$  согласуется с аналогичными данными, полученными на поликристаллических образцах ВТСП YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7- $\delta$ </sub> в сильных магнитных полях (см., например, [24]).

Появление электросопротивления гранулярных ВТСП в результате разрыва куперовских пар при  $T = T_c$  — не единственная ситуация, в которой для этих объектов

выполняется условие  $\rho \neq 0$ . Далее рассмотрена ситуация, в которой при  $T < T_c \ \rho \neq 0$  вследствие протекания процессов, связанных с эволюцией вихревой структуры в подсистеме слабых связей.

4.2. Появление резистивности при  $T < T_c$  в магнитном поле. Выше было показано, что все кривые  $\rho(T)_{H=\text{const}}$  для образцов гранулярного высокотемпературного сверхпроводника  $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$  в магнитном поле внешне носят сходный характер. При понижении температуры последовательно наблюдаются следующие четыре области на кривых температурной зависимости электросопротивления в магнитном поле  $\rho(T)_{H=\text{const}}$ :

1 — область "нормального" хода сопротивления при  $T > T_c;$ 

2 — "скачки" электросопротивления при  $T = T_c$ ;

3 — область появления сопротивления при  $T_{R=0} < T < T_c;$ 

4 — обращение сопротивления в нуль при  $T < T_{R=0}$ .

При наличии общих черт поведения всех кривых  $\rho(T)_{H=\text{const}}$  имеют место и заметные количественные различия в ходе этих кривых в зависимости от способа приложения магнитного поля (0H, HH или H0) и напряженности полей  $\mathbf{H}_{\text{ext}}$  или  $\mathbf{H}_{\text{treat}}$ .

Сразу отметим, что в области 1  $(T > T_c)$  ход кривых  $\rho(T)_{H=\text{const}}$  фактически не зависит ни от величины магнитного поля, ни от способа его приложения.

Особенности поведения зависимостей  $\rho(T)_{H=\text{const}}$ , а также  $d\rho/dT(T)$  в окрестности  $T_c$  (область 2) не зависят от способа приложения магнитного поля.

Существенные различия в ходе зависимостей  $\rho(T)_{H=\text{const}}$  имеют место в области 3 ( $T_{R=0} < T < T_c$ ). Для проведения сравнительного анализа особенностей поведения электросопротивления образцов от способа приложения магнитного поля и установления природы этих особенностей рассмотрим показанные на рис. 8 полевые зависимости температуры  $T_{R=0}(H)$ , при достижении которой появляется отличное от нуля сопротивление: в серии *HH* наблюдается практически линейная зависимость  $T_{R=0}(H_{\text{ext}})$ , в серии *OH* — появление аномалии (провала) на кривой  $T_{R=0}(H_{\text{ext}})$ , в серии *HO* — очень слабая зависимость  $T_{R=0}(H_{\text{treat}})$ .

Следует полагать, что совокупность данных о полевых зависимостях  $T_{R=0}$  физически эквивалентна температурным зависимостям критических полей фазовых переходов, сопровождающихся появлением резистивности при повышении температуры. Казалось бы, для гранулярных ВТСП YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7- $\delta$ </sub> ситуация " $\rho \neq 0$  при  $H = \text{const}^{"}$  начинает выполняться при повышении температуры, подобно ситуации " $\rho \neq 0$  при  $T = \text{const}^{"}$ , которая начинает выполняться при повышении напряженности магнитного поля. Все это указывает на возможность протекания фазовых переходов в подсистеме слабых связей, обусловленных либо полным разрушением их сверхпроводимости, либо разрывом образуемой ими непрерывной сверхпроводящей цепи (см., например, [24,25]). Хотя кривые  $T_{R=0}(H_{\text{ext}})$  и  $T_{R=0}(H_{\text{treat}})$  можно рассматривать



**Рис. 8.** Полевые зависимости температуры  $T_{R=0}$ , при которой обращается в нуль электросопротивление гранулярных ВТСП YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7- $\delta$ </sub>.

как "отражение" линий  $H_{c2J}(T)$  на фазовых H-Tдиаграммах, возможность "прямого" построения фазовых диаграмм на основе зависимостей  $\rho(T)_{H=\text{const}}$  далеко не очевидна в силу следующих причин:

1) при подобном подходе определению подлежат только значения верхних критических полей слабых связей  $H_{c2J}$  (критерии для определения значений полей  $H_{c1g}$ для сверхпроводящих гранул отсутствуют);

2) данные, необходимые для установления природы аномального хода зависимостей  $T_{R=0}(H_{ext})$  (серия 0H) и  $T_{R=0}(H_{treat})$  (серия H0), также отсутствуют.

В связи с этим представленные на рис. 8 данные в основном иллюстрируют существенные различия в ходе температурных зависимостей электросопротивления образцов при разных способах приложения магнитного поля. Для установления характера температурных зависимостей величин критических магнитных полей  $H_{c2J}$  и  $H_{c1g}$  в вихревой структуре гранулярных ВТСП YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7- $\delta$ </sub> в работе в основном применяется методический подход, основанный на анализе изотерм магнитосопротивления  $\rho(H)_{T=const.}$ 

4.3. Критические поля слабых связей и сверхпроводящих гранул. Значения критических магнитных полей слабых связей  $(H_{c2J})$  и сверхпроводящих гранул  $(H_{c1g})$  образцов гранулярного высокотемпературного сверхпроводника YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7- $\delta$ </sub> определялись на основании изотерм магнитосопротивления  $\rho(H)_{T=const}$ . Как хорошо известно (см., например, [4,18,19]), значению поля  $H_{c2J}$  соответствует начало отклонения хода кривой  $\rho(H)_{T=const}$  от нулевого уровня, значению поля  $H_{c1g}$  — появление особенности на кривой  $\rho(H)_{T=const}$ , связанной с началом протекания процессов проникновения магнитного поля в сверхпроводящие гранулы и перераспределения поля между сла-



**Рис. 9.** Температурные зависимости критических полей  $H_{c2J}$  и  $H_{c1g}$  гранулярных ВТСП YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7- $\delta$ </sub> для образцов серий 0H, HH и H0.

быми связями и гранулами. Температурные зависимости критических полей  $H_{c2J}$  и  $H_{c1g}$  представлены на рис. 9.

Как видно, характер этих зависимостей качественно различается: для серии 0*H* кривые  $H_{c2J}(T)$  и  $H_{c1g}(T)$  носят явно выраженный аномальный характер (при повышении температуры наблюдается резкое уменьшение поля  $H_{c1g}$  и заметный рост поля  $H_{c2J}$ ); для серии *HH* зависимости  $H_{c2J}(T)$  и  $H_{c1g}(T)$  имеют практически ли-

Следует полагать, что наличие столь существенных различий в ходе температурных зависимостей критических полей может быть обусловлено как начальными различиями в вихревой структуре образцов серий 0*H*, *HH* и *H*0, так и особенностями протекания процессов эволюции вихревой структуры в образцах различного типа.

Действительно, из приведенных на рис. 9 данных следует, что только в случае охлаждения образцов в FC-режиме температурные зависимости критических полей носят практически линейный характер, типичный для сверхпроводников второго рода [1] (в том числе и для гранулярных ВТСП [2]). Можно предположить, что сравнительно медленное охлаждение в магнитном поле обеспечивает поддержание динамического равновесия между плотностью вихрей Джозефсона и Абрикосова в обеих подсистемах двухуровневой системы гранулярных ВТСП.

Зависимости же  $H_{c2J}(T)$  и  $H_{c1g}(T)$  для образцов ВТСП YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7- $\delta$ </sub>, охлажденных в ZFC-режиме, носят явно выраженный аномальный характер. Приложение поля  $H_{ext}$  при  $T < T_c$  создает заведомо неравновесное распределение плотности вихрей Джозефсона и Абрикосова в двухуровневой системе, релаксация такого состояния может приводить к включению дополнительных механизмов эволюции вихревой структуры.

"Магнитная закалка" образцов серии H0, по-видимому, формирует в них магнитное состояние, когда приложение поля обработки  $\mathbf{H}_{\text{treat}}$  приводит к захвату сверхпроводящими гранулами магнитного поля  $\mathbf{H}_{\text{trap}}$ . Из-за низких значений  $H_{\text{trap}}$  (для появления магнитосопротивления гранул должно выполняться условие  $H_{\text{trap}} > H_{c1g}$ ) область появления магнитосопротивления сужается до 1.5-2 K, а величина критического поля  $H_{c2J} \rightarrow 0$ .

4.4. Температурные зависимости магнитосопротивления. Очевидно, что приведенные выше данные о существенном влиянии способа магнитной обработки гранулярного высокотемпературного сверхпроводника YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7- $\delta$ </sub> на особенности фазовых *H*-*T*диаграмм вносят весомый вклад в решение проблемы выяснения природы процессов формирования и эволюции вихревых структур. Однако основную, по нашему мнению, информацию о природе и механизмах подобных процессов несут данные об отклике обеих подсистем двухуровневой системы гранулярных ВТСП на внешнее воздействие — проникновение магнитного поля в виде вихрей Абрикосова и Джозефсона и взаимодействие вихрей с гранулами и межгранульными границами (слабыми связями).

Таким откликом, естественно, служит появление и последующее изменение величины и распределения по магнитному полю эффекта магнитосопротивле-



**Рис. 10.** Температурные зависимости суммарной величины магнитосопротивления гранулярных ВТСП YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7-δ</sub> для образцов серий 0*H*, *HH* и *H*0.

ния  $\rho(H)_{T=\text{const.}}$  В качестве интегральной меры этого эффекта можно рассматривать площадь под кривой  $\rho(H)_{T=\text{const}}$  — изотермой магнитосопротивления во всем диапазоне значений напряженности магнитного поля  $\mathbf{H}_{\text{ext}}$  (или  $\mathbf{H}_{\text{treat}}$ ):

$$S = \int_{0}^{H_{\text{max}}} \rho(H) dH.$$
 (2)

Температурные зависимости величин S(T) для серий 0H, HH и H0 образцов ВТСП  $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ , представленных на рис. 5–7, показаны на рис. 10.

Отличия в уровне магнитосопротивления образцов гранулярных ВТСП  $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$  различных серий очень велики. Так, соотношение между площадями под кривыми S(T) для образцов, охлажденных в FC-режиме (серия *HH*) и ZFC-режиме (серия *0H*), составляет примерно 1:3. Площадь под кривой S(T) для образца, подвергнутого "магнитной закалке" (серия *H0*), в несколько раз меньше.

На основании данных о поведении зависимостей S(T),  $H_{c2J}(T)$  и  $H_{c1g}(T)$  для образцов серий 0H, HH и H0можно восстановить адекватную картину возникновения и эволюции вихревой структуры в гранулярном ВТСП YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7- $\delta$ </sub>.

1. Сочетание умеренно высокого уровня магнитосопротивления с отсутствием аномалий (линейный ход температурных зависимостей величин критических полей слабых связей  $H_{c2J}$  и сверхпроводящих гранул  $H_{c1g}$  при приложении магнитного поля в FC-режиме свидетельствует в пользу гипотезы об установлении динамического равновесия между плотностью вихрей Джозефсона и Абрикосова в широком диапазоне температур и магнитных полей).

2. Магнитная обработка в "экстремальном" ZFC-режиме приводит к значительному повышению уровня магнитосопротивления и появлению аномальных температурных зависимостей величин критических полей  $H_{c2J}$  и  $H_{c1g}$ , что указывает на возможность генерации высокой плотности вихрей Джозефсона в межгранульной среде при начальном включении магнитного поля и последующей эволюции вихревой структуры путем перераспределения поля между слабыми связями и сверхпроводящими гранулами при  $\mathbf{H}_{ext} > H_{c1g}(T)$ .

3. Результатом "магнитной закалки" является наличие крайне низкого уровня магнитосопротивления и практически полное отсутствие вклада слабых связей в процесс диссипации, что указывает на малую величину захваченного поля **H**<sub>trap</sub>, создаваемого вихрями Абрикосова в сверхпроводящих гранулах.

### 5. Заключение

Стратегия достижения цели настоящей работы — установление природы и механизмов эволюции вихревой структуры гранулярного высокотемпературного сверхпроводника  $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$  под действием температуры и магнитного поля — заключалась в изучении в рамках единой программы резистивных характеристик образцов, строго идентичных по составу и свойствам, но различающихся способом приложения магнитного поля, и проведении сравнительного анализа полученных результатов.

Получены следующие основные результаты.

1. Установлено, что основным фактором, определяющим поведение резистивных и гальваномагнитных свойств гранулярных ВТСП  $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ , является способ приложения магнитного поля.

2. Показано, что независимо от способа приложения магнитного поля ход температурной зависимости электросопротивления в магнитном поле  $\rho(T)_{H=\text{const}}$  носит сходный характер.

3. Показано, что ход изотерм магнитосопротивления  $\rho(T)_{H=\text{const}}$  носит качественно различный характер в зависимости от способа приложения магнитного поля: появление максимумов (ZFC-режим), появление перегибов (FC-режим), выход на насыщение (FC-режим, сброс поля) в окрестности критического поля  $H_{c1g}$ .

4. Обнаружено, что температурные зависимости величин критических полей слабых связей  $(H_{c2J})$  и сверхпроводящих гранул  $(H_{c1g})$  носят линейный характер в случае приложения поля в FC-режиме, при приложении поля в ZFC-режиме зависимости  $H_{c2J}(T)$  и  $H_{c1g}(T)$  носят аномальный характер.

5. Показано, что величина суммарного магнитосопротивления в диапазоне от нуля до  $H_{\rm max}$  S резко уменьшается при переходе от ZFC- к FC-режиму приложения магнитного поля.

6. На основе сравнительного анализа температурных зависимостей величин электросопротивления, магнитосопротивления и критических полей фазовых переходов в образцах гранулярных ВТСП  $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ , подвергнутых различным видам магнитной обработки, развиты представления о природе и механизмах эволюции вихревой структуры под действием температуры и магнитного поля.

## Список литературы

- Л.В. Шубников, В.И. Хоткевич, Ю.Д. Шепелев, Ю.Н. Рябинин. ЖЭТФ 7, 2, 221 (1935).
- M. Tinkham, C.J. Lobb. Solid State Phys. 42, 91 (1989); L. Ji, M.S. Rzchowski, N. Anand, M. Tinkham. Phys. Rev. B 47, 470 (1993).
- [3] C.A.M. dos Santos, C.J.V. Oliveira, M.S. da Luz, A.D. Bortolozo, M.J.R. Sandim, A.J.S. Machado. Phys. Rev. B 74, 184 526 (2006).
- [4] В.В. Деревянко, Т.В. Сухарева, В.А. Финкель. ФТТ 46, 10, 1740 (2004).
- [5] В.В. Деревянко, Т.В. Сухарева, В.А. Финкель. ЖТФ **78**, *3*, 36 (2008).
- [6] Т.В. Сухарева, В.А. Финкель. ЖЭТФ 134, 5, 922 (2008).
- [7] Д.А. Балаев, А.А. Быков, С.А. Семенов, С.И. Попков, А.А. Дубровский, К.А. Шайхутдинов, М.И. Петров. ФТТ 53, 5, 865 (2011); Д.А. Балаев, А.А. Дубровский, К.А. Шайхутдинов, С.И. Попков, Д.М. Гохфельд, Ю.С. Гохфельд, М.И. Петров. ЖЭТФ 135, 2, 271 (2009).
- [8] C.A.M. dos Santos, M.S. da Luz, B. Ferreira, A.J.S. Machado. Physica C 391, 345 (2003).
- [9] M.S. da Luz, C.A.M. dos Santos, M.J.R. Sandim, A.J.S. Machado, R.F. Jardim. Brazil. J. Phys. 37, 1155 (2007).
- [10] K. Kiliç, A. Kiliç, H. Yetiş, O. Çetin. Phys. Rev. B 68, 144 513 (2003); J. Appl. Phys. 95, 1924 (2004); New J. Phys. 7, 212 (2005).
- [11] L. Burlachkov, E. Mogilko, Y. Schlesinger, Y.M. Strelniker, S. Havlin. Phys. Rev. B 67, 104 599 (2003).
- [12] D. Daghero, P. Mazzett, A. Stepanescu, P. Tura, A. Masoero. Phys. Rev. B 66, 184 514 (2002).
- [13] P. Mazzetti, A. Stepanescu, P. Tura, A. Masoero, I. Puica. Phys. Rev. B 65, 132 512 (2002).
- [14] O.V. Gerashchenko. Supercond. Sci. Technol. 16, 690 (2003).
- [15] V.V. Derevyanko, T.V. Sukhareva, V.A. Finkel. Functional Mater. 11, 4, 710 (2004).
- [16] В.В. Деревянко, Т.В. Сухарева, В.А. Финкель. ФТТ 48, 8, 1374 (2006).
- [17] В.В. Деревянко, Т.В. Сухарева, В.А. Финкель. ФТТ 49, 10, 1744 (2007).
- [18] Т.В. Сухарева, В.А. Финкель. ФТТ 52, 8, 1479 (2010).
- [19] D.A. Balaev, S.I. Popkov, E.I. Sabitova, S.V. Semenov, K.A. Shaykhutdinov, A.V. Shabanov, M.I. Petrov. J. Appl. Phys. 110, 093 918 (2011).
- [20] T.V. Sukhareva. J. Supercond. Novel Magn. 26, 5, 2021 (2013).
- [21] V.A. Finkel', V.M. Arzhavitin, A.A. Blinkin, V.V. Derevyanko, Yu.Yu. Razdovskii. Physica C 235–240, 303 (1994).
- [22] А.А. Блинкин, В.В. Деревянко, А.Н. Довбня, Т.В. Сухарева, В.А. Финкель, И.Н. Шляхов. ФТТ 48, 11, 1921 (2006).
- [23] U. De, S. Kalavathi, T.S. Radhakrihman, G.V. Subba Rao. J. de Phys. Coll. C8 (Suppl.) 49, 12, 2167 (1988).
- [24] T.V. Sukhareva, V.A. Finkel. Functional Mater. 16, 4, 408 (2009).
- [25] O.V. Gerashchenko, S.L. Ginzburg. Supercond. Sci. Technol. 18, 332 (2000).